

Title (en)

Process for improving the purity of transition metals obtained by electrolysis of their halides in molten salts baths.

Title (de)

Verfahren zur Erhöhung der Reinheit von Übergangsmetallen, die durch Elektrolyse aus ihren geschmolzenen Halogeniden gewonnen werden.

Title (fr)

Procédé d'amélioration de la pureté des métaux de transition obtenus par électrolyse de leurs halogénures en bain de sels fondus.

Publication

**EP 0197867 A1 19861015 (FR)**

Application

**EP 86420077 A 19860317**

Priority

FR 8504596 A 19850319

Abstract (en)

[origin: US4675084A] The present invention relates to a process for improving the purity of transition metals produced by electrolysis of halides thereof in a bath of molten salts in a tank having a metal internal wall. The process is characterised in that a cathodic potential with respect to the anode of the cell is permanently imposed on the tank. It finds application in the production of metals such as in particular titanium, zirconium, hafnium, vanadium, niobium and tantalum, with a low proportion of oxygen and foreign metal elements.

Abstract (fr)

La présente invention est relative à un procédé d'amélioration de la pureté des métaux de transition obtenus par électrolyse de leurs halogénures en bain de sels fondus dans une cuve à paroi interne métallique. Ce procédé est caractérisé par ce que l'on impose en permanence à la cuve un potentiel cathodique par rapport à l'anode de la cellule. Elle trouve son application dans la fabrication de métaux, tels que notamment le titane, le zirconium, l'hafnium, le vanadium, le niobium, le tantale, à faible teneur en oxygène et en éléments métalliques étrangers.

IPC 1-7

**C25C 3/26**; **C25C 7/06**

IPC 8 full level

**C25C 3/26** (2006.01); **C25C 7/06** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**C25C 3/26** (2013.01 - EP US); **C25C 7/06** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

[X] US 3082159 A 19630319 - REIMERT LAWRENCE J

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE GB IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)

**EP 0197867 A1 19861015**; **EP 0197867 B1 19881117**; AT E38693 T1 19881215; CA 1268446 A 19900501; DE 3661203 D1 19881222; FR 2579230 A1 19860926; FR 2579230 B1 19900525; JP H0213034 B2 19900403; JP S61217592 A 19860927; US 4675084 A 19870623

DOCDB simple family (application)

**EP 86420077 A 19860317**; AT 86420077 T 19860317; CA 504243 A 19860317; DE 3661203 T 19860317; FR 8504596 A 19850319; JP 5674486 A 19860314; US 82993786 A 19860218